

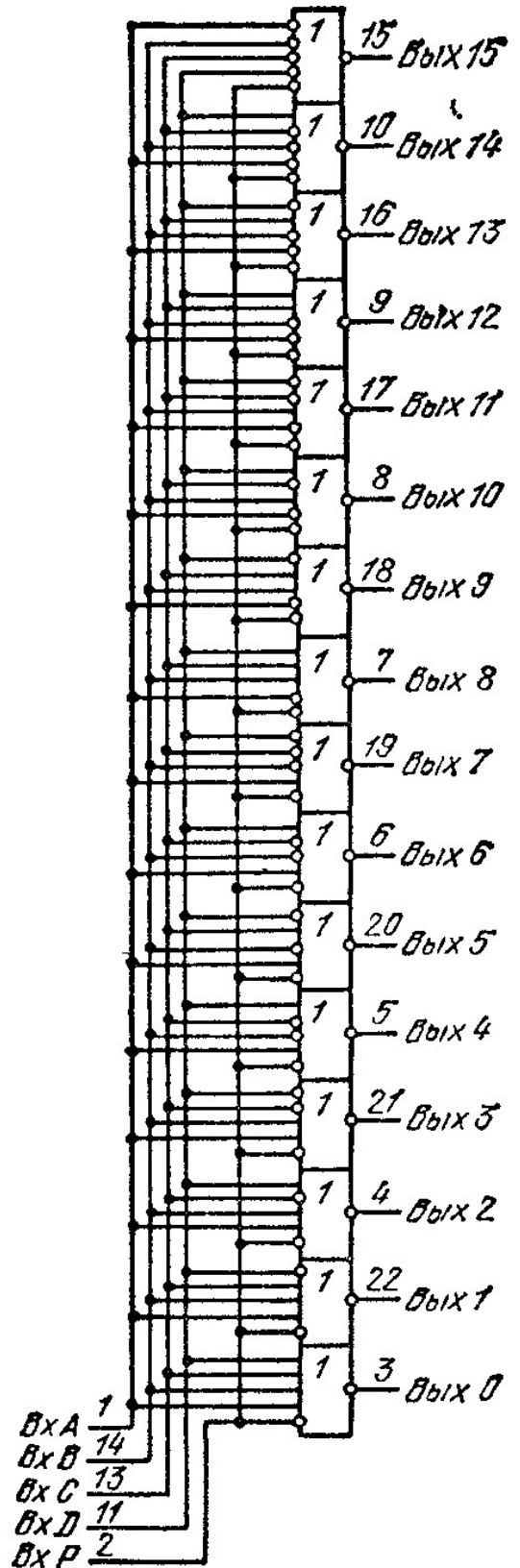
К5ИД011, К501ИД1П, КР501ИД1

Дешифратор 4-16, тип логики: МОП-структуры (р-канальные).

Корпус (К501ИД1П, КР501ИД1): прямоугольный пластмассовый 209.24-3.

Выводы: общий — 12; —Uип₁ — 24; Uип₂ — 23.

Напряжение источника питания: Uип₁ = —12 В±10%; Uип₂ = —27 В±10%.



Электрические параметры

Входное напряжение низкого уровня	> -2 В
Входное напряжение высокого уровня	< -8,5 В
Выходное напряжение низкого уровня	> -1 В
Выходное напряжение высокого уровня	< -9,5 В
Напряжение помехи, не более	1,0 В
Входной ток высокого уровня	< 0,4 мкА
Ток потребления $I_{пот1}$, не более	0,9 мА
Ток потребления $I_{пот2}$, не более	10,5 мА
Мощность потребления, не более	320 мВт
Время задержки сигнала при включении	< 1,8 мкс
Время задержки сигнала при выключении	< 1,6 мкс
Время перехода микросхемы из состояния «0» в состояние «1»	< 3 мкс
Время перехода микросхемы из состояния «1» в состояние «0»	< 3 мкс
Коэффициент разветвления	30
Емкость выводов ($f = 125$ кГц) :	
1	7 пФ
2	5 пФ
11, 13, 14	8 пФ

Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации

Напряжение положительной полярности на любом выводе, не более	0,3В
Напряжение источника питания:	
$U_{ип1}$, не менее	—20 В
$U_{ип2}$, не менее	—30 В
Входное напряжение, не менее	—30 В
Выходное напряжение, не менее	—20 В
Допустимое значение статического потенциала на выводах, не более	30 В

Условия применения (К501ИД1П, КР501ИД1)

Температура окружающей среды	-45...+70 °С
Многokrатное циклическое изменение температур	-45...+70 °С
Относительная влажность воздуха при +25 °С	98%
Синусоидальная вибрация (1-600 Гц)	10 g
Многokrатные удары с ускорением	75 g
Линейное ускорение	25 g

Допускается применение ИС при токе нагрузки 0,4 мА в состоянии «0» на выходе при изменении выходного напряжения «0» до —2 В. Допускается ток нагрузки до 1 мА в состоянии «0» без регламентации уровня. Допускается выходное напряжение —6,5 В в состоянии «1» при подключении резистора $R_n = 13$ КОМ между контролируемым и общим выводами микросхем.